**Блецкан Микола Іванович**

**БЛЕЦКА́Н Микола Іванович** (22. 07. 1938, с. Голятин, нині Міжгір. р-ну [Закарп. обл.](http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14610)) – фізик, матеріалознавець. Брат [Дмитра](http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35492) та [Михайла](http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35494) [Блецканів](http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35494). Д-р фіз.-мат. н. (1985). Премія РМ СРСР (1983). Закін. Ужгород. ун-т (1963). Працював ст. інж., майстром, нач. лаб. на Запоріз. титано-магнієвому з-ді (1963– 72), де вперше в СРСР розробляв пром. технологію кристалів кремнію та германію. Від 1972 – зав. відділу НДІ матеріалознавства (Москва), від 1974 за сумісн. – викл., ст. н. с. (від 1978), доц. (від 1983) Моск. ін-ту електрон. техніки. Наук. дослідж. в галузі напівпровідник. матеріалознавства. Розробляє технології росту кристалів Si, GaP, GaAs, InP, CdS, CdSe, CdTe, ZnSe та сапфіру. Від 1991 – дир., від 2000 – президент наук.-вироб. центру «Сапфір». 1991 в Ужгороді разом із братом Дмитром заснував наук.-вироб. фірму «Технокристал».

Пр.: Процессы реального кристаллообразования. Москва, 1977; Исследование процессов кристаллизации методом Степанова на вращающуюся затравку // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1985. Т. 49, № 49 (співавт.); Особенности образования ТД-II в кристаллах кремния, легированных германием // УФЖ. 1989. Т. 34, № 5 (співавт.); Кислород в монокристаллах кремния. К., 1997.

М. М. Вегеш